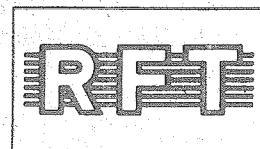


Information



SU 178, 179

2/84

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Schaltnetzteile

Maße in mm und Anschlußbelegung

Masse ca. 22 g
Kollektor am
Gehäuse

Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung $I_E = 0$	U_{CBO}	SU 178 800	SU 179 1000	V
Kollektor-Emitter-Spannung $I_B = 0$	U_{CEO}	400	450	V
Kollektorstrom	I_C	6		A
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	8		A
Gesamtverlustleistung $\vartheta_c = 50 \text{ }^\circ\text{C}$	P_{tot}	60		W
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	+150		$^\circ\text{C}$

Kennwerte, ($\theta_c = 25^\circ\text{C} - 5\text{K}$)

	min.	typ	max.
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{CE} = U_{CBO}, U_{BE} = -2\text{V}$			1,0 mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2,5\text{A}, I_B = 0,5\text{A}$			1,5 V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2,5\text{A}, I_B = 0,5\text{A}$			1,4 V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 100\text{mA}$			V
			V
			V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung $I_E = 10\text{mA}$			V
Abfallzeit des Kollektorstromes $I_C = 2,5\text{A}, I_B = 0,5\text{A},$ $- I_B = 1,0\text{A}$			1,0 μs

)¹ SU 178

)² SU 179

Bestellbezeichnung: Transistor SU 178
Transistor SU 179

Änderungen vorbehalten!

BE-Nr. SU 178: 137 82 14 106 178006
SU 179: 137 82 14 106 179084

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

RFT

Herausgeber:
Veb Applikationszentrum Elektronik Berlin
im Veb Kombinat Mikroelektronik

DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2881 011 3055